

12月1日午前

〔 12月1日 午前 〕

座長 堀 淳一

第1日の午前には、植村泰忠氏の Introductory Talk と、江沢洋氏による、サブ・バンド間遷移を考慮したときの反転層内易動度の計算結果の報告が行われた。

植村氏はMOSに関する簡潔且つ魅惑的な歴史的回顧から出発して、(1)MOSにおけるサブ・バンド形成の問題、(2)MOSにおける輸送現象の問題および(3)ヘリウム表面の電子の問題を極めて要領よく展望され、参会者一同スカッとした思いであった。

江沢氏は、Boltzmann方程式にもとずき、Sternによって計算されたHartree近似における波動関数を用いて、電子・フォノン散乱によって生じる電子の易動度を数値計算した結果を報告された。結果のこまかい点や、実験との合致がまだ非常によいとはいえない点について活発な議論が行われたが、今後の発展のよりどころとなる仕事であろう。(堀 淳一)